

# 化 工 業 曰 報

2008年(平成20年) 7月7日(月曜日)

## 高出力の深紫外LED

理研松下電工  
殺菌・医療など応用へ

理化学研究所(理研)と松下電工は4日、波長280㎚(ナノメートル)の深紫外領域の発光ダイオード(LED)を開発。10ワットの世界最高出力を達成したと発表した。窒化アルミニウムガリウムガリウムを数%添加した高品質な4元化合物半導体の成長に成功し、波長280㎚の深紫外領域で推定80%に達する内部量子効率を実現することによって、室温での連続大出力化が可能になった。

これまで高出力な深紫外LEDは開発できていなかつただけに、殺菌や医療照明、化粧品などへの応用が期待される。窒化アルミニウムガリウム系の半導体を用いたLEDや半導体レーザー(LED)は、波長200㎚から350㎚範囲の深紫外光での殺菌、浄水、医療、高演色照明、有機物質の高速分解、生化学、化学工業、センサーなど多様な応用が予想され、大型市場に発展することが見込まれる。しかし、従来の結晶成長プロセスでは結晶転移が多くできてしまつことや、p型半導体のホルム濃度が低く

療、照明、化粧品などへの応用が期待される。窒化アルミニウムガリウム系の半導体を用いたLEDや半導体レーザー(LED)は、波長200㎚から350㎚範囲の深紫外光での殺菌、浄水、医療、高演色照明、有機物質の高速分解、生化学、化学工業、センサーなど多様な応用が予想され、大型市場に発展することが見込まれる。しかし、従来の結晶成長プロセスでは結晶転移が多くできてしまつことや、p型半導体のホルム濃度が低く

どから、十分な発光効率が得られず、高出力化できていた。同研究グループは、アルミニウムの組成比を50%に高めることや、結晶成長速度を従来の3分の1に減速することで、十分な発光効率が得られず、高出力化できていた。同研究

現。またモジュレーションドーピングという方法で、電子注入、量子井戸内の原子層レベルの平坦性の改善と内部電界の抑制を実現することなどで、高出力化を達成した。この成果は、理研が推進する「産業界との融合連携プログラム」の一環として得られたもの。